

委員各位

日本学術振興会ワイドギャップ半導体
光・電子デバイス第 162 委員会
委員長 吉川 明彦

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会
第 72 回委員会・第 76 回研究会 開催案内

日時：平成 23 年 10 月 7 日（金）

委員会：12：00 - 12：45

研究会：12：45 - 16：50

場所：キャンパス・イノベーションセンター東京（田町駅前）1 階国際会議室

URL：http://www.cictokyo.jp/

〒108-0023 東京都港区芝浦 30-3-6 TEL:03-5440-9020

委員会

議題：

- （1）前回第 71 回委員会議事録承認について
- （2）委員の異動について
- （3）次回第 77 研究会（12 月）およびそれ以降の研究会について
- （4）ワイドギャップ半導体スクールについて
- （5）その他

研究会 主 題：「先端評価 物性制御」

委員長挨拶・企画趣旨説明（12:45-12:50）

1. 「EBSD 法による AlGaN/GaN ヘテロ構造の深さ方向歪み解析」（12:50-13:35）

石堂輝樹¹，片山琢磨¹，松尾尚慶²，上田哲三¹，上田大助³，パナソニック(株) セミコンダクター社 半導体デバイス研究センター¹，パワー・オプトデバイスビジネスユニット²，本社 R&D 部門 先端技術研究所³

2. 「IV 族系半導体における歪・欠陥の評価と制御」（13:35-14:20）

酒井 朗，大阪大学 大学院基礎工学研究科

3. 「SCM・SSRMを用いたワイドギャップ半導体のキャリア濃度評価」（14:20-15:05）

藤田高弥，(株) 東レリサーチセンター 表面解析研究部

休憩（15:05-15:20）

4. 「ラマン散乱分光による SiC 及び GaN 評価」（15:20-16:05）

播磨 弘，京都工業繊維大学 大学院工芸科学研究科

5. 「赤外分光法による InN およびその他窒化物半導体評価」（16:05-16:50）

石谷善博¹，藤原昌幸¹，今井大地¹，王 新強²，草部一秀¹，吉川明彦¹，千葉大学 大学院工学研究科¹，北京大学物理学科²

<追記>

1. 委員会では昼食を用意いたします。
2. 弁当準備の都合等があるため，委員会・研究会の出欠を 9 月 22 日（木）までに日本学術振興会研究事業課 檜崎 様（jigyouka09@jsps.go.jp）まで，必ずご連絡くださいますようお願いいたします。